Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-152516

(43) Date of publication of application: 30.05.2000

(51)Int.Cl.

H02J 7/10 H02J 7/00

(21)Application number : 10-324258

(71)Applicant: NEC SAITAMA LTD

(22)Date of filing:

13.11.1998

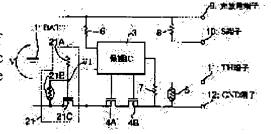
(72)Inventor: UMEZAWA ATSUSHI

(54) BATTERY PACK TEMPERATURE PROTECTING CIRCUIT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a battery pack temperature protecting circuit, capable of attaining size and weight reduction in a battery pack without causing cost increase in the assembling work.

SOLUTION: A serial resistor circuit, formed by serial-connecting a resistor element 21A having a prescribed resistance value with a thermistor 21B, is parallel-connected with a battery 1 (BATT), and a switching circuit constituted of an FET21C is serially connected with the battery 1. An electric potential V1, obtained by voltage-dividing the voltage V of the batter 1 through the resistor element 21A and the thermistor 21B, is supplied to the gate of the FET21C. When ambient temperature changes, the resistance value of the thermistor 21B is changed, and the electric potential V1 obtained by voltage-dividing the voltage V of the battery 1 through the resistor element 21A and the thermistor 21B changes. As a result, the FET21C is in a cut-off condition, so that a current route of the battery 1 to the outside is shut down.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-152516

(P2000-152516A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.Cl. [†]		識別記号	
H02J	7/10		
	7/00		

FI H02J 7/10 7/00 テーマコート*(参考) 5 G O O 3

審査請求 有 請求項の数5 OL (全 7 頁)

特顯平10-324258

(22)出願日

平成10年11月13日(1998.11.13)

(71)出康人 390010179

埼玉日本電気株式会社

埼玉県児玉郡神川町大字元原字豊原300番

18

(72)発明者 梅澤 淳

埼玉県児玉郡神川町大字元原字豊原300番

18 埼玉日本電気株式会社内

(74)代理人 100108578

弁理士 高橋 留男 (外3名)

Fターム(参考) 50003 BA01 CB01 CC02 DA04 FA04

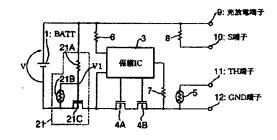
FA08 GA01

(54) 【発明の名称】 電池パック温度保護回路

(57)【要約】

【課題】 組み立て費用の上昇を招くことがなく、しかも電池パックを小形軽量化することを可能とする電池パック温度保護回路を提供すること。

【解決手段】 所定の抵抗値を有する抵抗素子21Aとサーミスタ21Bとを直列接続してなる直列抵抗回路が電池1 (BATT) に対して並列接続され、FET21 Cからなるスイッチ回路が電池1に対して直列接続され、電池1の電圧Vを抵抗素子21Aとサーミスタ21 Bにより分圧して得られる電位V1がFET21Cのゲートに与えられる。ここで、周囲の温度が変化すると、サーミスタ21Bの抵抗値が変化し、電池1の電圧Vを抵抗素子21Aとサーミスタ21Bにより分圧して得られる電位V1が変化する。この結果、FET21Cがカットオフ状態となって、電池1と外部との電流経路が遮断される。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電池に対して並列接続され、所定の抵抗 値を有する抵抗素子と周囲温度に応じて抵抗値が変化す るサーミスタとを直列接続してなる直列抵抗回路と、 前記電池に対して直列接続され、前記抵抗索子とサーミ スタとの接続点に現れる電位に応じて開閉するスイッチ 回路と、

を備えたことを特徴とする電池パック温度保護回路。 【請求項2】 前記直列抵抗回路は、

前記電池の正極側に前記抵抗素子を接続すると共に、前 10 記電池の負極側に前記サーミスタを接続してなり、

前記スイッチ回路は、前記電池の負極関に該電池と直列 に接続されたことを特徴とする請求項1に記載された電 池パック温度保護回路。

【請求項3】 前記直列抵抗回路は、

前記電池の正極側に前記サーミスタを接続すると共に、 前記電池の負極側に前記抵抗素子を接続してなり、 前記スイッチ回路は、前記電池の負極側に該電池と直列 に接続されたことを特徴とする請求項1に記載された電

【請求項4】 前記サーミスタは、温度の上昇に伴って 抵抗値が減少する負特性を有することを特徴とする請求 項2または3のいずれかに記載された電池パック温度保 護回路.

【請求項5】 前記サーミスタは、温度の上昇に伴って 抵抗値が増加する正特性を有することを特徴とする請求 項2または3のいずれかに記載された電池パック温度保 護回路。

【発明の詳細な説明】

池バック温度保護回路。

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電池バックを異常 温度から保護するための電池バック温度保護回路に関す ъ.

[0002]

【従来の技術】従来、リチウム電池などの電池パックで は、過電圧や過電流、あるいは温度の上昇を検出して電 源回路を遮断する機能を備えており、この機能を実現す るための電源バック温度保護回路として温度保護素子を 内蔵している。

【0003】図12に、この種の従来の電池パックの回 40 路構成を示す。同図において、符号1は充電式の二次電 池、符号2は異常温度から電池(BATT)1を保護す るための温度保護素子、符号3は充電時の過電圧や電池 パック使用時の過電流を監視する保護IC、符号4Aお よび4 Bは保護IC3からの信号に基づきオン/オフす るFET、符号5は、この電池パックが接続された充電 器に異常温度を検出させる為のNTCサーミスタ、符号 6,7は保護IC3に付属する抵抗素子、符号8は、充 電器に充電電圧を検出させる為の抵抗素子、符号9は充 放電端子、符号10は抵抗素子9が接続されたS端子。

符号11はNTCサーミスタ5が接続されたTH端子、 符号12は、GND端子である。上述の充放電端子9、 S端子10、TH端子11、GND端子12は外部の充 電器や装置側との接続用端子をなす。

【0004】この温度保護素子2を備える従来の電池パ ックによれば、通常の温度では、温度保護素子2が導通 状態となっており、電池1の正極は充放電端子9に接続 される。また、保護IC3は、過電圧や過電流を検出し ない限り、FET4A、4Bを導通状態とし、電池1の 負極はFET4A、4Bを介してGND端子12と接続 される。したがってこの場合、放電時には、充放電場子 9とGND端子12には、それぞれ電池1の正極および 負極の電位が現れ、外部の装置に電力が供給される。ま た、充電時には、外部の充電器からの電位が充放電端子 9およびGND端子12を介して電池1に与えられる。 【0005】ここで、過充電や過放電により電池1が発 熱し、電池パックの内部が異常温度となった場合、温度 保護素子2が遮断状態となって、電池1の正極を充放電 端子9から切り離す。これにより、外部の充電器と電池 1の正極との間の電流経路が遮断される結果、電池1の 発熱が抑制され、電池1が異常温度から保護される。

[00061

【発明が解決しようとする課題】ところで、温度保護素 子2としては、一般には例えばポリスイッチや温度ヒュ ーズが用いられる。しかしながら、ポリスイッチは重量 が重く、かつリードタイプである為、これを電池パック に組み込む際に手作業による半田付けや溶接技術を必要 としていた。このため、電池バックの粗立費用が高くな り、しかも小型軽量化が困難であるという問題点があっ 30 た。

【0007】また、温度ヒューズは、重量は軽いもの の、リードタイプであるため、ポリスイッチと同様に組 み立て費用が高くなるという問題に加え、異常温度によ り断線されるため、再使用が出来ないといった問題点が あった。

【0008】この発明はかかる事情に鑑みてなされたも ので、組み立て費用の上昇を招くことなく、しかも電池 パックを小形軽量化することを可能とする電池パック温 度保護回路を提供することを課題とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決達成する ため、この発明は以下の構成を有する。すなわち、請求 項1にかかる発明は、電池に対して並列接続され、所定 の抵抗値を有する抵抗素子と周囲温度に応じて抵抗値が 変化するサーミスタとを直列接続してなる直列抵抗回路 と、前記電池に対して直列接続され、前記抵抗素子とサ ーミスタとの接続点に現れる電位に応じて開閉するスイ ッチ回路と、を備えたことを特徴とする。

【0010】この発明によれば、サーミスタの抵抗値が 50 周囲の温度に応じて変化する、電池の電圧は抵抗索子と

サーミスタとにより分圧され、これらの接続点に現れる 電位がスイッチ回路に与えられる。このとき、スイッチ 回路は、この接続点に現れる電位に応じて開閉する。し たがって、抵抗素子の抵抗値、サーミスタの温度特性、 またはスイッチ回路の動作点を適切に選べば、周囲温度 が予め設定された温度を越えた場合に、スイッチ回路を 開放させて、電池を外部から遮断することが可能とな ъ.

【0011】請求項2にかかる発明は、前配直列抵抗回 路が、前記電池の正極側に前記抵抗素子を接続すると共 10 タ21 Bが接続される。 に、前記電池の負極側に前記サーミスタを接続してな り、前記スイッチ回路は、前記電池の負極側に該電池と 直列に接続されたことを特徴とする。

【0012】請求項3にかかる発明は、前記直列抵抗回 路が、前記電池の正極側に前記サーミスタを接続すると 共に、前記電池の負極側に前記抵抗素子を接続してな り、前記スイッチ回路は、前記電池の負極側に該電池と 直列に接続されたことを特徴とする。

【0013】請求項4にかかる発明は、前記サーミスタ が、温度の上昇に伴って抵抗値が減少する負特性を有す 20 ることを特徴とする。請求項5にかかる発明は、前記サ ーミスタが、温度の上昇に伴って抵抗値が増加する正特 性を有することを特徴とする。

【0014】上述の本発明によれば、設定した温度以上 になるとスイッチをオフし、回路を遮断する。つまり、 抵抗素子とサーミスタによりこれらの接続点に現れる電 圧を調整し、温度変化によりサーミスタの抵抗値が変化 することを利用して、予め設定した温度を越えると、ス イッチ回路がオフとなり回路を遮断する。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、この発明にかかる実施の形 態について図面を参照して説明する。なお、各図におい て、前述の従来技術にかかる図12に示す要素と共通す る要素には同一符号を付し、その説明を適宜省略する。 【0016】実施の形態1. 図1に、この実施の形態1 にかかる電池パック温度保護回路21が適用された電池 パックの回路構成を示す。同図に示す電池パックは、前 述の従来技術にかかる図12に示す構成において、温度 保護素子2に代え、この発明にかかる電池パック温度保 護回路21を備える。この電池パック温度保護回路21 40 は、図2に示すように、所定の抵抗値を有する抵抗案子*

> $V1 = V \times RTH1 / (R1 + RTH1)$ \cdots (1)

[0021]

ただし、Vは電池1の両極間の電圧であり、RTH1は サーミスタ21Bの抵抗値であり、R1は抵抗素子21 Aの抵抗値である。

【0022】この式(1)で与えられる電圧V1がFE T21Cのゲートに与えられる結果、FET21Cのゲ ート電圧が調整され、FET21Cの導通/非導通状態 が制御される。したがって、抵抗素子21Aの抵抗値、

*21A(固定抵抗)と、周囲温度に応じて抵抗値が変化 するサーミスタ21Bと、Nチャネル型のFET (電界 効果型トランジスタ)21Cとからなる。

【0017】ここで、抵抗素子21Aとサーミスタ21 Bは互いに直列接続されて直列抵抗回路を構成する。 こ の直列抵抗回路は、図1に示す充放電端子9およびGN D端子12から見て、電池1 (例えばリチウム電池) に 対して並列に接続される。また、電池1の正極側には抵 抗索子21Aが接続され、電池1の負極側にはサーミス

【0018】すなわち、抵抗素子21Aの一端は電池1 の正極に接続されると共にその他端はサーミスタ21B の一端に接続され、このサーミスタ21Bの他端は電池 1の負極に接続される。これにより、抵抗素子21Aと サーミスタ21Bとの接続点には、電池1の電圧V(電 池1の負極と正極との間の電位差)を抵抗素子21Aと サーミスタ21Bとにより分圧して得られる電圧V1が 現れる。

【0019】また、FET21Cは、電圧V1に応じて 開閉するスイッチ回路を構成し、GND端子12と電池 1との間に直列に接続されている。すなわち、FET2 1Cの電流経路の一端(ソース)は電池1の負極に接続 され、他端 (ドレイン) はFET4A, 4Bを介してG ND端子12に接続され、そのゲートは抵抗素子21A とサーミスタ21Bとの接続点に接続されている。ここ で、サーミスタ21Bは、NTC型のサーミスタであ り、図3に例示するように、周囲温度の上昇に対して抵 抗値が減少する負の特性を有する。

【0020】以下、この実施の形態1にかかる電池パッ 30 ク温度保護回路21の動作を説明する。例えば過充電や 過放電により電池1が発熱すると、サーミスタ21Bの 周囲温度が上昇する。サーミスタ21Bの周囲温度が変 化(上昇)すると、図3に示す特性曲線に沿って、サー ミスタ21 Bの抵抗値が熱(周囲温度)により変化(減 少)し、周囲温度に応じた抵抗値を示す。このとき、抵 抗素子21Aとサーミスタ21Bとの接続点に現れる電 圧V1は、下式(1)により算出され、後述する図4に 示すように、周囲温度の上昇に伴って低下する傾向を示

※さい値電圧を選択することにより、電池1の負極とGN D端子12との間を遮断状態とするための温度を設定す ることができる。以下、電池1の負極とGND端子12 との間の遮断を希望する温度を「設定温度」と記す。

【0023】この実施形態1では、例えば抵抗素子21 Aを20kΩの固定抵抗とした場合、電圧V1は、図4 に例示する温度特性を有するものとなる。 図4から分か サーミスタ21Bの温度特性、FET21Cのゲートし%50 るように、この例では、FET21Cのゲートカットオ

フ電圧 (ゲートしきい値電圧)を1V程度に設定すれ ば、周囲温度が約90℃以上になった場合にFET21 Cがオフ状態となる。この結果、電池1の負極とGND 端子12の間が遮断され、それまでFET21Cを流れ ていた電流 I 1 が流れなくなり、電池 1 が異常温度から 保護される。

【0024】また、図1に示す電池バックによれば、保 護IC3が過電流や過電圧から電池1を保護するための 監視を行い、過電流や過電圧が発生した場合は保護IC 流や過電圧から保護するための制御動作を行う。この動 作に加えて、異常温度に対しては電池パック温度保護回 路21が上記の動作を行い、設定値以上の温度となった 場合にFET21Cをオフさせて回路を遮断する。

【0025】以上説明したように、この実施の形態1で は、周囲温度の上昇に応じて電圧V1が低下する傾向を 示す特性(図4に示す特性)を利用し、設定温度におけ*

 $V2=V\times R1/(R1+RTH1)$

ただし、Vは電池1の両極間の電圧であり、RTH1は サーミスタ21日の抵抗値であり、R1は抵抗案子21 Aの抵抗値である。

【0028】ここで、サーミスタ21Bの特性と抵抗業 子21Aの抵抗値として、前述の実施の形態1で用いた ものを採用すれば、電圧V2は、図6に示すように、周 囲温度の上昇に伴って上昇する特性を有するものとな る。この特性を利用し、設定温度に合わせてFET21 Cのゲートカットオフ電圧を選択すれば、設定温度以上 の場合にFET21Cをオンさせ、設定温度以下の場合 にオフさせて、GND端子12から電池1の負極に流れ 込む電流 I 1を遮断することが可能となる。したがっ て、この実施形態2によれば、低温側に異常温度を設定 することが可能となる.

【0029】実施の形態3. 図7に、この発明の実施の 形態3にかかる電池パック温度保護回路23が適用され た電池パックの回路構成を示す。この電池パック温度保 護回路23は、前述の図1及び図2に示す電池パック温 度保護回路21の構成において、NTC型のサーミスタ 21BをPTC型のサーミスタ23Bに入れ替えて構成 される。

するように、周囲温度の上昇に伴って110℃付近で抵 抗値が増加する正の特性を有する。この場合、抵抗素子 21A(20kΩ)とサーミスタ23Bとの接続点に現 れる電圧V3は、図9に示すように、周囲温度の上昇に 伴って110℃付近で増加する傾向を示す特性を有する ものとなる。

【0031】この特性を利用し、希望温度に合わせてF ET21Cのゲートカットオフ電圧を選択すれば、設定 温度以上の場合にFET21Cをオンさせ、設定温度以 下の場合にオフさせて、GND端子12から流れ込む電※50

* る電圧V1に合わせてFET21Cのゲートカットオフ 電圧を選択することにより、設定温度以下の場合にFE T21Cをオンさせ、設定温度以上の場合にオフさせ て、GND端子12から電池1の負極に流れ込む電流I 1を遮断し、電池1を異常温度から保護する。したがっ て、この実施の形態1によれば、高温側に異常温度を設 定することが可能となる。

【0026】実施の形態2. 図5に、この発明の実施の 形態2にかかる電池バック温度保護回路22が適用され 3がトランジスタ4A,4Bをオフさせ、電池1を過電 10 た電池パックの回路構成を示す。同図に示す電池パック 温度保護回路22は、前述の図1及び図2に示す電池パ ック温度保護回路21の構成において、抵抗素子21A とサーミスタ21Bとを入れ替えて構成される。この場 合、抵抗素子21Aとサーミスタ21Bとの接続点に現 れる電圧V2は、下式(2)により算出される。

[0027]

30

 \cdots (2)

※流 1 1を遮断することが可能となる。

【0032】実施の形態4.図10に、この発明の実施 の形態4にかかる電池パック温度保護回路24が適用さ れた電池パックの回路構成を示す。この電池パック温度 保護回路24は、前述の図7に示す電池バック温度保護 回路23の構成において、抵抗素子21AとPTC型の サーミスタ23Bとを入れ替えて構成される。

【0033】この場合、抵抗素子21Aとサーミスタ2 3Bとの接続点に現れる電圧V4は、図11に示すよう に、周囲温度の上昇に伴って110℃付近で減少する傾 向を示す特性を有するものとなる。この特性を利用し、 設定温度に合わせてFET21Cのゲートカットオフ電 圧を選択すれば、設定温度以下の場合にFET21Cを オンさせ、設定温度以上の場合にオフさせて、GND端 子12から流れ込む電流 I1を遮断することが可能とな

【0034】上述の各実施の形態によれば、電池パック 温度保護回路を構成する各部品は小型軽量であり、しか も表面実装部品であるため、電池バックの小形軽量化及 び自動搭載が可能となり、製造コストも低減される。

【0035】以上、この発明の実施の形態を説明した 【0030】ここで、サーミスタ23Bは、図8に例示 40 が、この発明は、この実施形態に限られるものではな く、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等があ っても本発明に含まれる。例えば、上述の各実施の形態 では、電池1の負極とGND端子12との間にFET2 1Cを設けて、電池1の負極とGND端子12との間を 遮断するものとしたが、電池1の正極と充放電端子9と の間に例えばPチャネル型のFETを設けて、電池1の 正極と充放電端子9との間を遮断するようにする事も可 能である。

[0036]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば

以下の効果を得ることができる。すなわち、所定の抵抗値を有する抵抗素子と周囲温度に応じて抵抗値が変化するサーミスタとを直列接続して、これらを電池に対して並列接続し、前記電池に対してスイッチ回路を直列接続し、前記抵抗素子とサーミスタとの接続点に現れる電位に応じて前記スイッチ回路を開閉するようにしたので、組み立て費用の増加を招くことなく電池パックを小形軽量化することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1にかかる電池パック 10の回路図である。

【図2】 この発明の実施の形態1にかかる電池バック 温度保護回路の回路図である。

【図3】 この発明の実施の形態1にかかるサーミスタ (NTC型)の抵抗値の温度依存性を示す特性図であ る。

【図4】 この発明の実施の形態1にかかる直列抵抗回路における電圧V1の温度依存性を示す特性図である。

【図5】 この発明の実施の形態2にかかる電池バックの回路図である。

【図6】 この発明の実施の形態2にかかる直列抵抗回路における電圧V2の温度依存性を示す特性図である。

【図7】 この発明の実施の形態3にかかる電池パックの回路図である。

【図8】 この発明の実施の形態3にかかるサーミスタ (PTC型)の抵抗値の温度依存性を示す特性図であ

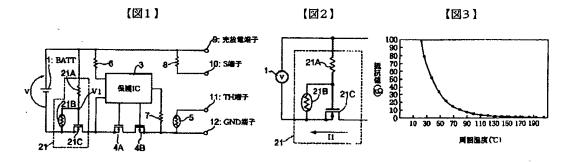
【図9】 この発明の実施の形態3にかかる直列抵抗回路における電圧V3の温度依存性を示す特性図である。 【図10】 この発明の実施の形態4にかかる電池パックの回路図である。

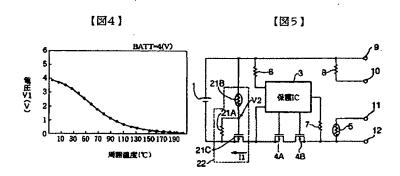
0 【図11】 この発明の実施の形態4にかかる直列抵抗 回路における電圧V4の温度依存性を示す特性図であ

【図12】 従来技術にかかる電池パックの回路図である。

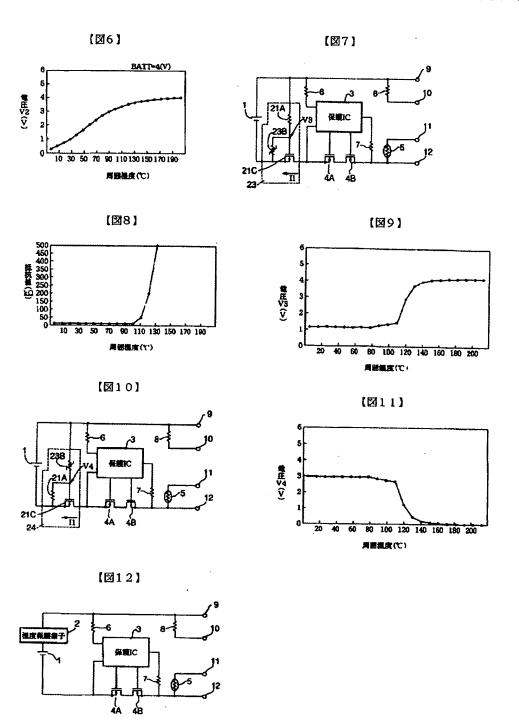
【符号の説明】

1…電池(BATT)、21~24…電池バック温度保 護回路、21A,6~8…抵抗素子、21B…サーミス タ(NTC型)、21C,4A,4B…FET(Nチャ ネル型)、23B…サーミスタ(PTC型)、3…保護 IC、5…サーミスタ、9…充放電端子、10…S端 子、11…TH端子、12…GND端子。





(16) 000-152516 (P2000-152516A)



【手続補正書】

【提出日】平成11年11月18日(1999.11. 18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電池に対して並列接続され、所定の抵抗 値を有する抵抗素子と周囲温度に応じて抵抗値が変化す るサーミスタとを直列接続してなる直列抵抗回路と、

前記電池に対して直列接続されると共にゲートが前記抵抗素子とサーミスタとの接続点に接続され、前記周囲温度が予め設定された温度を越えた場合に前記抵抗素子とサーミスタとの接続点に現れる電位に応じて開放する電界効果型トランジスタからなるスイッチ回路と、

を備えたことを特徴とする電池バック温度保護回路。

【請求項2】 前記直列抵抗回路は、

前記電池の正極側に前記抵抗素子を接続すると共に、前記電池の負極側に前記サーミスタを接続してなり、

前記スイッチ回路は、前記電池の負極側に該電池と直列 に接続されたことを特徴とする請求項1に記載された電 池バック温度保護回路。

【請求項3】 前記直列抵抗回路は、

前記電池の正極側に前記サーミスタを接続すると共に、前記電池の負極側に前記抵抗素子を接続してなり、前記スイッチ回路は、前記電池の負極側に該電池と直列

に接続されたことを特徴とする請求項1に記載された電池パック温度保護回路。

【請求項4】 前記サーミスタは、温度の上昇に伴って 抵抗値が減少する負特性を有することを特徴とする請求 項2または3のいずれかに記載された電池パック温度保 護回路。

【請求項5】 前記サーミスタは、温度の上昇に伴って 抵抗値が増加する正特性を有することを特徴とする請求 項2または3のいずれかに記載された電池バック温度保 護回路。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決達成するため、この発明は以下の構成を有する。すなわち、請求項1にかかる発明は、電池に対して並列接続され、所定の抵抗値を有する抵抗素子と周囲温度に応じて抵抗値が変化するサーミスタとを直列接続してなる直列抵抗回路と、前記電池に対して直列接続されると共にゲートが前記抵抗素子とサーミスタとの接続点に接続され、前記周囲温度が予め設定された温度を越えた場合に前記抵抗素子とサーミスタとの接続点に現れる電位に応じて開放する電界効果型トランジスタからなるスイッチ回路と、を備えたことを特徴とする。